



Ф.И.О.: Асатова Умида Палвановна
 ДОЛЖНОСТЬ: старший преподаватель
 ТЕЛ: +99893 746 27 57
 E – mail: umida72@rambler.ru;
asatova.umida72@gmail.com
umida72@urdu.uz
 ТЕЛЕФОН ОРГАНИЗАЦИИ: +99862 2246700
 АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ: г.Ургенч, ул.Х.Олимджана 14. 220100

ОБРАЗОВАНИЕ, СТЕПЕНЬ	<ul style="list-style-type: none"> • 1989 - 1994 Ташкентский государственный университет (студент) • 1994-1995 Ургенчский государственный университет(стажер) • 2017-2020 Ургенчский государственный университет(базовый докторант) • 2021 доктор философии (PhD) по физико-математическим наукам
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:	<ul style="list-style-type: none"> • 1995 – 2001 ассистент преподаватель кафедры физики Ургенчского государственного университета. • 2001 – 2017 старший преподаватель кафедры физики Ургенчского государственного университета. • 2020 по настоящее время старший преподаватель кафедры физики Ургенчского государственного университета
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ	<ul style="list-style-type: none"> • Физик.
ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ПРЕДМЕТЫ	<ul style="list-style-type: none"> • Физика полупроводников и диэлектриков, Атомная физика, Ядерная физика
ОБЛАСТЬ НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ:	<ul style="list-style-type: none"> • Выращивание и изучение структурных, электрофизических и фотоэлектрических свойств полупроводниковых узкозонных твердых растворов.
ПУБЛИКАЦИИ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saidov A.S., Leyderman A.Yu, Usmonov Sh.N., Asatova U.P. Peculiarities of the Current–Voltage Characteristic of n-GaP–p-(InSb)_{1-x}(Sn₂)_x Heterostructures // Technical Physics Letters, 2020 .– Vol. 46, No.11. – pp. 1124–1127. (№3 Scopus, IF = 0.773) 2. Saidov A., Usmonov Sh., Asatova U. Features of epitaxy of the layers of solid solutions (InSb)_{1-x}(Sn₂)_x on GaAs substrates // Euroasian Journal of Semiconductors Science and Engineering. – Tashkent, 2020. –Vol. 2, No.6. – pp. 36–39. (01.00.00; №16) 3. Саидов А.С., Усмонов Ш.Н., Асатова У.П. Особенности эпитаксии слоев твердых растворов (InSb)_{1-x}(Sn₂)_x на GaAs подложках // Труды международной конференции “Тенденции развития современной физики полупроводников: Проблемы, достижения и перспективы”. – Ташкент, 28-мая 2020г.– С. 263-269.

4. Asatova U. P., Features of current transfer in n-GaP-p-(InSb)_{1-x}(Sn₂)_x heterostructure // Electronic journal of actual problems of modern science, education and training. – Urgench, 2019. – No.5. – pp. 25–33. (01.00.00; №10)
5. Saidov A.S., Usmonov Sh.N., Asatova U.P., Ishniyozov T. Structural features of solid solutions (InSb)_{1-x}(Sn₂)_x films grown from a liquid phase on GaAs substrates and some photoelectric properties of heterostructures on their basis // Electronic journal of actual problems of modern science, education and training. – Urgench, 2019. – No.3. – pp. 7–23. (01.00.00; №10)
6. Saidov A.S., Usmonov Sh.N., Asatova U.P. Growth of Ge_{1-x}Sn_x Solid Solution Films and Study of Their Structural Properties and Some of Their Photoelectric Properties // Semiconductors. – New York, 2012.–Vol.46, No.8. – pp. 1088–1095. (№3 Scopus, IF = 0.691)
7. Саидов А.С., Лейдерман А.Ю., Усмонов Ш. Н., Асатова У.П. Температурные особенности вольт-амперных характеристик n-GaP-p-(InSb)_{1-x}(Sn₂)_x гетероструктур // Доклады Академии наук Республики Узбекистан. – Ташкент, 2010. – №5. – С.23–26. (01.00.00; №7)
8. Saidov A.S., Usmonov Sh.N., Asatova U.P. Active Solar Energy Material Science Thermoelectric Properties of n-Ge-p-(InSb)_{1-x}(Sn₂)_x Heterostructures // Applied Solar Energy, 2010. – Vol. 46, No. 2. – pp. 104–106 (№3 Scopus)
9. Saidov A.S., Usmonov Sh.N., Asatova U.P., Ismailov Sh.K. Growing and studying the photoelectric and electrical properties of epitaxial films Ge_{1-x}Sn_x solid solutions // Scientific-Technical Journal Turin polytechnic university. – Tashkent, 2019. – No.1. – pp. 93–104.
10. Саидов А.С., Усмонов Ш.Н., Асатова У.П., Ишниязов Т., Некоторые фотоэлектрические свойства гетероструктур на основе эпитаксиальных слоев твердых растворов (InSb)_{1-x}(Sn₂)_x полученных из жидкой фазы. Materials of international conference “The modern problems of renewable energy sources and sustainable environment”. – Tashkent, September 25-27, 2019. – pp. 42-47.
11. Saidov A.S., Usmonov Sh.N., Asatova U.P., Ismailov Sh.K. Growth of Ge_{1-x} Sn_x solid solution films by Liquid phase epitaxy and study of their photoelectric and structural properties // “2nd International Conference on Applied Science AeroSpace Engineering”. – Tokyo, Japan, June 24-25, 2019.
12. Асатова У.П., Усмонов Ш.Н. Исследование рельефа поверхности эпитаксиальной пленки TP Ge_{1-x}Sn_x (0 ≤ x ≤ 0.03) // Respublika Imiy-Amaliy Konferensiyasi (RIAK-XII). – Tashkent, 18 may 2019. – С. 345–346.
13. Саидов А.С., Усмонов Ш.Н., Асатова У.П., Исмоилов Ш.К. О структуре TP Ge_{1-x}Sn_x // Мухаммад Ал-Хоразмий издошлар мавзусидаги Республика-илмий техникавий анжуман материаллари. – Урганч, 2018. – С. 64–66.
14. Саидов А.С., Лейдерман А.Ю., Усмонов Ш. Н., Асатова У.П. Выращивание и исследование фотоэлектрических свойств эпитаксиальных пленок твердого раствора Ge_{1-x}Sn_x с нанокристаллами. // Физика ва уни ўқитишнинг долзарб муаммолари мавзусидаги илмий ва илмий-методик маколалар туплами. – Гулистон, 2018. – С. 111–129.
15. Саидов А.С., Усмонов Ш. Н., Асатова У.П., Исмоилов Ш. К. О структуре TP Ge_{1-x}Sn_x // Образование и воспитание. Международный журнал. – Казань, № 3.1. 2018. – С.24–26.
16. Саидов А.С., Усмонов Ш. Н., Асатова У.П. Структурные особенности TP Ge_{1-x}Sn_x (0 < x < 0.03) // Труды международной конференции . – Ташкент, 13–14 июня 2017. – С.49–53.
17. Асатова У.П., Исмаилов Ш. К. О возможности синтеза узкозонных твердых растворов замещения (InSb)_{1-x}(Sn₂)_x // Al-Xorazmiy nomli Urganch davlat universitetining Imiy-metodik jurnali Ilm sarchashmalari. – Urganch, 2015. – №12. – С. 14–17.

18. Асатова У.П. Выращивание пленок $(\text{InSb})_{1-x}(\text{Sn}_2)_x$ на арсенид-галлиевых подложках методом жидкофазной эпитаксии // Республика ёш олимлар ва иктидорли талабалар мактаб-семинари материаллари. Замонавий физиканинг долзарб муаммолари. – Самарканд, 28-29 мая 2010. – С. 106–110
19. Асатова У.П., Усмонов Ш.Н. Спектральная фоточувствительность $n\text{-GaAs-p-(InSb)}_{1-x}(\text{Sn}_2)_x$ структур // Материалы Республиканской конференции «Современная физика и ее перспективы». – Ташкент, 12–13 ноября 2009. – С.247–249.
20. Саидов А.С., Усмонов Ш.Н., Асатова У.П. Спектральная фоточувствительность $n\text{-Ge-p-Ge}_{1-x}\text{Sn}_x$ структур // Тезисы докладов 2-Международной научной конференции. Физика и Физическое образование: Достижения и перспективы развития. – Бишкек, 18-20 сентября 2008. – С.22.
21. Раззаков А.Ш., Асатова У.П., Исмоилов Ш.К. Синтез трехкомпонентных твердых растворов $(\text{Sn}_2)_x(\text{InSb})_{1-x}$ // Материалы Республиканской научно-технической конференции с участием зарубежных ученых «Композиционные материалы: Структура, свойства и применение». – Ташкент, 27-28 июня 2008. – С.136–138.
22. Саидов М.С., Саидов А.С., Асатова У. П., Исмоилов Ш.К. “Рост, свойства и применение кристаллов” // Материалы IV Республиканской научной конференции. – Андижан, 2008. – С. 37–38.
23. Saidov A.S, Ismoilov Sh.K, Asatova U.P. Liquid phase epitaxy of solid solutions. // Magnetic and Superconducting Materials MSM 07. – Khiva, 25 th-30 th September, 2007. – pp.100–101.
24. Saidov A.S, Asatova U.P., Ismoilov Sh. K. Growing of the $(\text{Sn}_2)_{1-x}(\text{InSb})_x$ epitaxial layers on the GaAs substrate from a liquid phase // Magnetic and Superconducting Materials MSM 07. – Khiva, 25 th-30 th September, 2007. – p.54.
25. Saidov A.S, Leyderman A.Yu, Ismoilov Sh.K., Asatova U.P. Electrical and photoelectrical properties of thin films on base $n\text{-GaAs-p-(Sn}_2)_{1-x}(\text{InSb})_x$ structures // Magnetic and Superconducting Materials MSM 07. – Khiva, 25 th-30 th September, 2007. – p. 54.
26. Саидов А.С, Кошчанов Э.А., Раззаков А.Ш., Асатова У.П. Токовые характеристики $\text{GaAs-(Sn}_2)_x(\text{InSb})_{1-x}$ гетероструктур // Труды конференции посвященной 60-летию Академии наук Республики Узбекистан и Физико-технического института «Фундаментальные и прикладные вопросы физики». – Ташкент, 27-28 ноября 2003 . – С.342-343.
27. Саидов А.С., Раззаков А. Ш., Сапаров Д. В., Давлатов У.Т., Асатова У.П., Саидниёзов О. Некоторые электрофизические свойства $n\text{GaAs-p-(Sn}_2)_{1-x}(\text{InSb})_x$ // Вестник ГулГУ. – Гулистон, 2002. – №2. – С.3–7.
28. Саидов А.С., Раззаков А. Ш., Кошчанов Э.А., Асатова У.П. Кристаллизация слоев полупроводниковых твердых растворов $\text{Ge}_{1-x}\text{Sn}_x$ из жидкой фазы // Труды второй международной научно-практической конференции «Современные информационные и электронные технологии». – Одесса, 28-31 мая 2001 . – С.273.